

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

состояние от корпуса до начала изгиба вывода 1,5 мм с радиусом изгиба 0,5 мм.

пускается односторонний изгиб выводов на расстоянии не менее 1 мм от радиуса закругления не менее 0,5 мм, при этом запрещается выводов вокруг собственной оси. Допускается изгиб выводов на более 10° непосредственно у корпуса.

пускается скол обоя на выводах.

пускается установку диодных матриц на печатные платы производить или в отверстия.

зрешается соединение диодных матриц с элементами аппаратуры ми способами на расстоянии не менее 3 мм от корпуса диодной матрицы, щими нагрев корпуса диодной матрицы выше 130°С_и прохождение ия в электрического тока через элементы диодной матрицы.

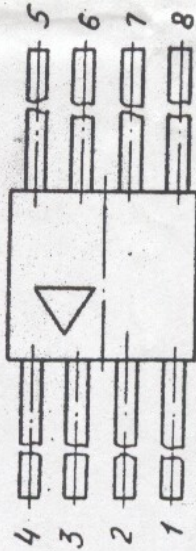
ику производить в течение 2-3с с теплоотводом между корпусом матрицы и местом пайки. В качестве теплоотвода рекомендуется в пинцет с плоскими медными губками шириной не менее 1 мм и не менее 1 мм.

комендуется пайку производить оловянно-свинцовым припоем.

Диодные матрицы
2ДС523ВМ

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диодные матрицы типа 2ДС523ВМ в пластмассовом корпусе, состоящие из четырех элементов с разделенными минусовыми и плюсовыми электродами, с индивидуальной стеклянной герметизацией каждого элемента, предназначенные для работы в устройствах специального назначения.



Типы диодных матриц обозначаются кодом на верхней поверхности корпуса со стороны выводов "минус": тип 2ДС523 ВМ -разносторонний треугольник.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (при $t_{обр}=25 \pm 10^{\circ}\text{C}$)

Именованное параметра, жим измерения, иница измерения.	Буквенное обозначение	Норма не более
остоянный обратный ток ($I_{обр}=50\text{В}$), мкА	$I_{обр}$	5
остоянное прямое напряжение ($I_{пр}=20\text{мА}$), В	$V_{пр}$	1
ряд восстановления ($I_{пр}=20\text{мА}$, $V_{обр,н}=10\text{В}$), мкс	$t_{вос}$	150
зность прямых напряжений жду всеми элементами диодной атрицы (при одинаковом токе в апазоне постоянных прямых токов ,05+2мА), мВ	$\Delta V_{пр}$	10
бная емкость (для типа 2АС523ВМ ($V_{обр}=0,1\text{В}$), пф	C_d	2,5
ремя обратного восстановления ($I_{пр}=10\text{мА}$ на $V_{обр}=10\text{В}$, ровень отсчета $I_{обр}=5\text{мА}$), нс	$t_{вос,обр}$	4

Примечание: Все параметры, за исключением $t_{вос,обр}$ пр приведены для каждого элемента диодной матрицы.

Содержание драгоценных металлов в 1000шт. диодных матриц

Золото 0,0296 г
Серебро 0,0719 г

Сведения о приемке

Диодные матрицы типа 2АС523ВМ, соответствуют техническим условиям

ГТЗ.362.143 ТУ. Дополнения № 1.

Приняты по извещению № 342 от 07.01 г. 1974 дата

Место для штампа ОТК

СТЗ.118

Место для штампа "Перепроверка произведена" дата

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика